## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-164607

(43)Date of publication of application: 16.06.2000

(51)Int.CI.

H01L 21/52 C09J133/14 C09J161/10

C09J163/00 H01L 23/12

(21)Application number: 10-332099

(22)Date of filing:

10-332099 24.11.1998

(71) (ppiloant

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor: SHIMADA YASUSHI

KURITANI HIROYUKI INADA TEIICHI

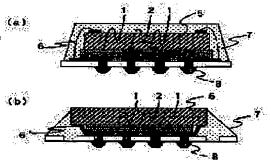
TANAKA HIROKO KAMISHIRO YASUSHI YAMAMOTO KAZUNORI

# (54) ELECTRONIC PART ADHESIVE MEMBER, SEMICONDUCTOR MOUNTING WIRING BOARD EQUIPPED THEREWITH, AND SEMICONDUCTOR DEVICE PROVIDED THEREWITH

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a semiconductor device to be enhanced in temperature cycle resistance and reflow resistance after it is subjected to a moisture absorption treatment by a method wherein an adhesive layer is formed on both the surfaces of a core formed of inorganic woven or nonwoven fabric.

SOLUTION: An adhesive layer 1 is formed on both the surfaces of a core 2 formed of inorganic woven or nonwoven fabric for the formation of an electronic part adhesive member. A semiconductor chip 5 is bonded by thermocompression under a certain condition to the one surface of the electronic part adhesive member opposite to its other surface where a wiring board is provided, the adhesive layer 1 of the electronic part adhesive member is heated for a prescribed time to be cured, and then the pads of the semiconductor chip 5 and a wiring on the wiring board are connected together with a bonding wire 6. The inner lead 6' of the wiring board is bonded to the pad of the semiconductor chip 5, the semiconductor chip 5 and the bonding wires 6 are sealed up with sealing material 7, and solder balls as outer connection terminals 8 are provided for the formation of a semiconductor device.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-164607 (P2000-164607A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

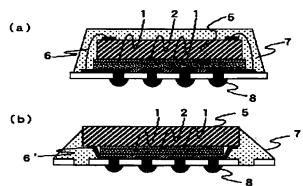
			(==, ==, ==, ==, ==, ==, ==, ==, ==, ==,	. ,,,, , - , ,			
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)		
H01L 21/52		H01L 2	1/52	${f E}$	4J040		
C 0 9 J 133/14		C 0 9 J 133/14			5 F 0 4 7		
161/10		161/10 163/00					
163/00							
H01L 23/12		H01L 23/12 L					
	·	審査請求	未請求 請	求項の数10 C	)L (全 10 頁)		
(21)出願番号	特願平10-332099	(71)出願人	000004455				
			日立化成工	業株式会社			
(22) 出願日	平成10年11月24日(1998.11.24)		東京都新宿	区西新宿2丁目	11番1号		
		(72)発明者	島田靖				
			茨城県下館	市大字小川1500	番地 日立化成		
			工業株式会	社下館研究所内	]		
		(72)発明者	栗谷 弘之				
			茨城県下館	市大字小川1500	番地 日立化成		
			工業株式会	社下館研究所內	I		
		(74)代理人	100071559				
			弁理士 若	林 邦彦			
			弁理士 若	林 邦彦	最終買に		

## (54) 【発明の名称】 電子部品用接着部材、電子部品用接着部材を備えた半導体搭載用配線基板及びこれを用いた半導 体装置

## (57)【要約】

【課題】 配線基板に熱膨張係数の差が大きい半導体チップを実装する場合に必要な耐熱性、耐湿性を有する接着部材、この接着部材を備えた半導体搭載用配線基板及びこの接着部材を用いて半導体チップと配線基板を接着させた半導体装置を提供する。

【解決手段】 無機物の織布または不織布からなるコア 材の両面に接着剤層を備え電子部品用接着部材とする。 その電子部品用接着部材を配線基板の半導体チップ搭載 面に備え半導体搭載用配線基板とする。半導体チップと 配線基板の間に電子部品用接着部材を用いて接着させ半 導体装置とする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 無機物の織布または不織布からなるコア 材の両面に接着剤層を備えたことを特徴とする電子部品 用接着部材。

1

【請求項2】 コア材の表面がカップリング剤により処理されたことを特徴とする請求項1に記載の電子部品用接着部材。

【請求項3】 動的粘弾性測定装置を用いて測定した場合の貯蔵弾性率が25℃で20~2,000MPaであり、260℃で3~50MPaである硬化物特性を有する接着剤層をコア材の両面に備えたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電子部品用接着部材。

【請求項4】 以下の組成を有する接着剤層をコア材の 両面に備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項3 のいずれかに記載の電子部品用接着部材。

- (1) エポキシ樹脂及びその硬化剤100重量部、
- (2) エポキシ樹脂と相溶性がありかつ重量平均分子量が3万以上の高分子量樹脂5~40重量部、(3) グリシジル(メタ) アクリレート2~6重量%を含むTg(ガラス転移温度)が-10℃以上でかつ重量平均分子 20量が80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重合体100~300重量部、(4)硬化促進剤0.1~5重量部。

【請求項5】 以下の組成を有する接着剤層をコア材の 両面に備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項3 のいずれかに記載の電子部品用接着部材。

- (1) エポキシ樹脂及びその硬化剤100重量部、
- (2) グリシジル (メタ) アクリレート2~6 重量%を含むTg (ガラス転移温度) が-10℃以上でかつ重量平均分子量が80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重合体100~300重量部、(3) 硬化促進剤0.1~5重量部。

【請求項6】 以下の組成を有する接着剤層をコア材の 両面に備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項3 のいずれかに記載の電子部品用接着部材。

- (1) エポキシ樹脂及びフェノール樹脂100重量部、
- (2) フェノキシ樹脂 5~40重量部、(3) グリシジル (メタ) アクリレート 2~6重量%を含むTg (ガラス転移温度) が-10℃以上でかつ重量平均分子量が80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重合体100~300重量部、(4) 硬化促進剤0.1~5重量部。

【請求項7】 以下の組成を有する接着剤層をコア材の 両面に備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項3 のいずれかに記載の電子部品用接着部材。

- (1) エポキシ樹脂及びフェノール樹脂100重量部、
- (2) グリシジル (メタ) アクリレート  $2\sim6$  重量%を含む Tg (ガラス転移温度) が-10  $\mathbb C$ 以上でかつ重量 平均分子量が 80 万以上であるエポキシ基含有アクリル 系共重合体  $100\sim300$  重量部、 (3) 硬化促進剤

#### 0.1~5重量部。

【請求項8】 配線基板の半導体チップ搭載面に請求項 1ないし請求項7のいずれかに記載の電子部品用接着部 材を備えた半導体搭載用配線基板。

【請求項9】 半導体チップと配線基板を請求項1ない し請求項7のいずれかに記載の電子部品用接着部材を用 いて接着させた半導体装置。

【請求項10】 半導体チップの面積が、配線基板の面積の70%以上である半導体チップと配線基板を請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の電子部品用接着部材を用いて接着させた半導体装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品用接着部材、電子部品用接着部材を備えた半導体搭載用配線基板及び電子部品用接着部材を用いて半導体チップとインターポーザと呼ばれる配線基板とを接着させた半導体装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、電子機器の発達に伴い電子部品の 搭載密度が高くなり、チップスケールパッケージやチッ プサイズパッケージ(以下CSPと呼ぶ)と呼ばれるよ うな半導体チップサイズとほぼ同等なサイズを有する半 導体パッケージや半導体のベアチップ実装など新しい形 式の実装方法が採用され始めている。

【0003】半導体素子をはじめとする各種電子部品を 搭載した実装基板として最も重要な特性の一つとして信 頼性がある。その中でも、熱疲労に対する接続信頼性は 実装基板を用いた機器の信頼性に直接関係するため非常 に重要な項目である。この接続信頼性を低下させる原因 として、熱膨張係数の異なる各種材料を用いていること から生じる熱応力が挙げられる。これは、半導体チップ の熱膨張係数が約4ppm/℃と小さいのに対し、電子 部品を実装する配線板の熱膨張係数が15ppm/℃以 上と大きいことから熱衝撃に対して熱ひずみが発生し、 その熱ひずみによって熱応力が発生するものである。従 来のQFPやSOP等のリードフレームを有する半導体 パッケージを実装した基板では、リードフレームの部分 で熱応力を吸収し信頼性を保っていた。しかし、ベアチ ップ実装では、はんだボールを用いて半導体チップの電 極と配線板の配線パッドを接続する方式やバンプと呼ば れる小突起を作製して導電ペーストで接続する方式を取 っており、熱応力がこの接続部に集中して接続信頼性を 低下させていた。この熱応力を分散させるためにアンダ ーフィルと呼ばれる樹脂をチップと配線板の間に注入さ せることが有効であることがわかっているが、実装工程 を増やし、コストアップを招いていた。また、従来のワ イヤボンディングを用いて半導体チップの電極と配線板 の配線パッドを接続する方式もあるが、ワイヤを保護す るために封止材樹脂を被覆せねばならずやはり実装工程

を増やしていた。

【0004】CSPは他の電子部品と一括して実装でき るために、日刊工業新聞社発行表面実装技術1997-3号記事「実用化に入ったCSP (ファインピッチBG A) のゆくえ」中の5ページ表1に示されたような各種 構造が提案されている。その中でも、インターポーザと 呼ばれる配線基板にテープやキャリア基板を用いた方式 の実用化が進んでいる。これは、前述表の中で、テセラ 社やTI社などが開発している方式を含むものである。 これらはインターポーザと呼ばれる配線基板を介するた めに、信学技報CPM96-121、ICD96-16 0(1996-12)「テープBGAタイプCSPの開 発」やシャープ技報第66号(1996-12)「チッ プサイズパッケージ (Chip Size Packa ge) 開発」に発表されているように優れた接続信頼性 を示している。これらのCSPの半導体チップとインタ ーポーザと呼ばれる配線基板との間には、それぞれの熱 膨張率差から生じる熱応力を低減するような接着部材が 使われることが好ましい。かつ、耐湿性や高温耐久性も 要求される。さらに、製造工程管理のしやすさから、フ ィルムタイプの接着部材が求められている。

【0005】フィルムタイプの接着剤は、フレキシブルプリント配線板等で用いられており、アクリロニトリルブタジエンゴムを主成分とする系が多く用いられている。プリント配線板関連材料として耐湿性を向上させたものとしては、特開昭60-243180号公報に示されるアクリル系樹脂、エポキシ樹脂、ポリイソシアネート及び無機フィラーを含む接着剤があり、また特開昭61-138680号公報に示されるアクリル系樹脂、エポキシ樹脂、分子中にウレタン結合を有する両末端が第1級アミン化合物及び無機フィラーを含む接着剤があり、これらを接着部材として使用することは、構造上、プロセス上可能である。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】フィルムタイプの接着 剤は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主成分とする 系が多く用いられている。しかし、高温で長時間処理し た後の接着力の低下が大きいことや、耐電食性に劣るこ となどの欠点があった。特に、半導体関連部品の信頼性 評価で用いられるPCT(プレッシャークッカーテス ト)処理等の厳しい条件下で耐湿性試験を行った場合の 劣化が大きかった。特開昭60-243180号公報、 特開昭61-138680号公報に示されるものは、P CT処理等の厳しい条件下での耐湿性試験での劣化が大きかった。

【0007】これらプリント配線板関連材料としての接着剤を用いて半導体チップを配線基板に実装する場合には、半導体チップとインターポーザと呼ばれる配線基板の熱膨張係数の差が大きく、温度サイクルテストの劣化が大きく使用できなかった。また、吸湿処理後の耐リフ 50

ロー性やPCT処理等の厳しい条件下での信頼性試験を 行った場合の劣化が大きく、使用できなかった。

【0008】本発明は、ガラスエポキシ基板やフレキシブル基板等のインターポーザと呼ばれる配線基板に熱膨張係数の差が大きい半導体チップを実装する場合に必要な耐熱性、耐湿性を有する電子部品用接着部材、この電子部品用接着部材を備えた半導体搭載用配線基板、及びこの電子部品用接着部材を用いて半導体チップと配線基板を接着させた半導体装置の提供を目的とし、電子部品用接着部材の取り扱い性向上を課題とした。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、無機物の織布または不織布からなるコア材の両面に接着剤層を備えたことを特徴とする電子部品用接着部材である。コア材の表面は接着剤層との接着力を確保するためにをカップリング剤により処理されていることが好ましい。

【0010】また、本発明は、上記コア材の両面に、動 的粘弾性測定装置を用いて測定した場合の貯蔵弾性率が 25°Cで20~2,000MPaであり、260°Cで3 ~50MPaである硬化物特性を有する接着剤層を備え た電子部品用接着部材であると好ましい。そして本発明 は、(1)エポキシ樹脂及びその硬化剤100重量部、 (2) エポキシ樹脂と相溶性がありかつ重量平均分子量 が3万以上の高分子量樹脂5~40重量部、(3)グリ シジル (メタ) アクリレート2~6 重量%を含むTg (ガラス転移温度) が-10℃以上でかつ重量平均分子 量が80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重合 体100~300重量部、(4)硬化促進剤0.1~5 重量部を含む接着剤層を備えると好ましい電子部品用接 着部材で、具体的にはエポキシ樹脂の硬化剤がフェノー ル樹脂で、エポキシ樹脂と相溶性がありかつ重量平均分 子量が3万以上の高分子量樹脂であるフェノキシ樹脂を 用いた、(1)エポキシ樹脂及びフェノール樹脂100 重量部、(2)フェノキシ樹脂5~40重量部、(3) グリシジル(メタ)アクリレート2~6重量%を含むT g (ガラス転移温度) が-10℃以上でかつ重量平均分 子量が80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重 合体100~300重量部、(4)硬化促進剤0.1~ 5 重量部を含む接着剤層を備えた電子部品用接着部材で ある。また、本発明は、(1)エポキシ樹脂及びその硬 化剤100重量部、(2) グリシジル(メタ) アクリレ ート2~6重量%を含むTg(ガラス転移温度)が**-**1 0℃以上でかつ重量平均分子量が80万以上であるエポ キシ基含有アクリル系共重合体100~300重量部、 (3) 硬化促進剤 0.1~5 重量部を含む接着剤層を備 えると好ましい電子部品用接着部材で、具体的にはエポ キシ樹脂の硬化剤がフェノール樹脂である(1)エポキ シ樹脂及びフェノール樹脂100重量部、(2)グリシ ジル(メタ)アクリレート2~6重量%を含むTg(ガ ラス転移温度)が-10℃以上でかつ重量平均分子量が

80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重合体1 00~300重量部、(3) 硬化促進剤0.1~5重量 部を含む接着剤層を備えた電子部品用接着部材である。

【0011】更に、本発明は、配線基板の半導体チップ 搭載面に上記電子部品用接着部材を備えた半導体搭載用 配線基板である。

【0012】そして、本発明は、上記電子部品用接着部 材を用いて半導体チップとインターポーザと呼ばれる配 線基板を接着させた半導体装置である。特に、半導体チ ップの面積が、配線基板の面積の70%以上であると好 10 ましい半導体装置である。

#### [0013]

【発明の実施の形態】本発明において使用するコア材 は、無機物の織布または不織布とする。無機物は、有機 物と比較して経時劣化が少ない材料であり、耐熱性、耐 湿性等に優れている。また、無機物の織布または不織布 でない無機物の薄板を用いた場合には、打ち抜き加工等 の加工性が著しく劣るという問題が発生するが、無機物 の織布または不織布であるとそういった問題は解消され る。さらに、織布または不織布とした場合には、ロール 状で取り扱うのが容易であり、ラミネータでの接着剤の 貼り付けが連続で可能であり、生産性を上げることが可 能となる。このコア材の厚みは、5~200μmである ことが望ましいが、特に制限するものではない。無機物 の織布としては、ガラス織布、アルミナ織布、シリカ・ アルミナ織布などが例示される。これらの無機物の織布 は、日東紡績株式会社、旭ファイバーグラス株式会社、 日本硝子繊維株式会社、ユニチカグラスファイバー株式 会社などから市販されている。特に、ガラス織布は、C ガラス、Dガラス、Eガラス、Sガラス、ARガラス 等、各種グレードのものがあり、厚みも30~200μ mのものが実用化されている。無機物の不織布として は、ガラス不織布、アルミナ不織布、シリカ・アルミナ 不織布、水酸化アルミ不織布、炭酸カルシウム不織布な どが例示される。これらの不織布は、日本バイリーン株 式会社、オリベスト株式会社などから市販されている。 不織布の厚みは加圧により変化するため、厚みの規定が 難しく、単位面積当たりの重量(以下、坪量と称す)で 表すことが多い。本発明においては、半導体装置に組み 込まれた状態での厚みが5~200μπであることが望 ましく、30~150g/m2の仕様のものを用いるこ

【0014】コア材には、接着剤層となる接着剤との界 面結合をよくするために、カップリング剤処理をするこ とが望ましい。カップリング剤としては、シラン系カッ プリング剤、チタネート系カップリング剤、アルミニウ ム系カップリング剤が挙げられ、その中でもシランカッ プリング剤が好ましい。シランカップリング剤として は、
ッ
ー
グ
リ
シ
ド
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
メ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン
、
ッ

プロピルトリエトキシシラン、ャーウレイドプロピルト リエトキシシラン、N-β-アミノエチルーγ-アミノ プロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。前記した シランカップリング剤は、γーグリシドキシプロピルト リメトキシシランがNUC A-187、y-メルカプ トプロピルトリメトキシシランがNUC A-189、 y-アミノプロピルトリエトキシシランがNUC A-1100、γーウレイドプロピルトリエトキシシランが NUC A-1160,  $N-\beta-P \le J \times \mathcal{F} \mathcal{N} - \gamma - \mathcal{P}$ ミノプロピルトリメトキシシランがNUC A-112 0という商品名で、いずれも日本ユニカー株式会社から 市販されている。

【0015】本発明において接着剤層に使用するエポキ シ樹脂は、硬化して接着作用を呈するものであればよ く、二官能以上で、好ましくは分子量が5000未満、 より好ましくは3000未満のエポキシ樹脂が使用でき る。二官能エポキシ樹脂としては、ビスフェノールA型 またはビスフェノールF型樹脂等が例示される。ビスフ エノールA型またはビスフェノールF型液状樹脂は、油 化シェルエポキシ株式会社から、エピコート807、エ ピコート827、エピコート828という商品名で市販 されている。また、ダウケミカル日本株式会社からは、 D. E. R. 330, D. E. R. 331, D. E. R. 361という商品名で市販されている。さらに、東 都化成株式会社から、YD8125、YDF8170と いう商品名で市販されている。

【0016】エポキシ樹脂としては、高Tg化を目的に 多官能エポキシ樹脂を加えてもよく、多官能エポキシ樹 脂としては、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、ク レゾールノボラック型エポキシ樹脂等が例示される。フ エノールノボラック型エポキシ樹脂は、日本化薬株式会 社から、EPPN-201という商品名で市販されてい る。クレゾールノボラック型エポキシ樹脂は、住友化学 工業株式会社から、ESCN-190、ESCN-19 5という商品名で市販されている。また、前記日本化薬 株式会社から、EOCN1012、EOCN1025、 EOCN1027という商品名で市販されている。さら に、前記東都化成株式会社から、YDCN701、YD CN702、YDCN703、YDCN704という商 品名で市販されている。

【0017】エポキシ樹脂の硬化剤は、エポキシ樹脂の 硬化剤として通常用いられているものを使用でき、アミ ン、ポリアミド、酸無水物、ポリスルフィッド、三弗化 硼素及びフェノール性水酸基を1分子中に2個以上有す る化合物であるビスフェノールA、ビスフェノールF、 ビスフェノールS等が挙げられる。特に吸湿時の耐電食 性に優れるためフェノール樹脂であるフェノールノボラ ック樹脂、ビスフェノールノボラック樹脂またはクレゾ ールノボラック樹脂等を用いるのが好ましい。このよう ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、γーアミノ 50 な好ましいとした硬化剤は、大日本インキ化学工業株式

会社から、フェノライトLF2882、フェノライトLF2822、フェノライトTD-2090、フェノライトTD-2149、フェノライトVH4150、フェノライトVH4170という商品名で市販されている。

【0018】硬化剤とともに硬化促進剤を用いるのが好ましく、硬化促進剤としては、各種イミダゾール類を用いるのが好ましい。イミダゾールとしては、2ーメチルイミダゾール、2ーエチルー4ーメチルイミダゾール、1ーシアノエチルー2ーフェニルイミダゾリウムトリメリテー 10ト等が挙げられる。イミダゾール類は、四国化成工業株式会社から、2E4MZ、2PZ-CN、2PZ-CNSという商品名で市販されている。

【0019】接着剤層に使用するエポキシ樹脂と相溶性 がありかつ重量平均分子量が3万以上の高分子量樹脂と しては、フェノキシ樹脂、高分子量エポキシ樹脂、超高 分子量エポキシ樹脂、極性の大きい官能基含有ゴム、極 性の大きい官能基含有反応性ゴムなどが挙げられる。 B ステージにおける接着剤層のタック性の低減や硬化時の 可撓性を向上させるため重量平均分子量が3万以上とさ れる。前記極性の大きい官能基含有反応性ゴムは、アク リルゴムにカルボキシル基のような極性が大きい官能基 を付加したゴムが挙げられる。ここで、エポキシ樹脂と 相溶性があるとは、硬化後にエポキシ樹脂と分離して二 つ以上の相に分かれることなく、均質混和物を形成する 性質を言う。エポキシ樹脂と相溶性がありかつ重量平均 分子量が3万以上の高分子量樹脂の配合量は、エポキシ 樹脂を主成分とする相(以下エポキシ樹脂相という)の 可撓性の不足、タック性の低減やクラック等による絶縁 性の低下を防止するため5重量部以上、エポキシ樹脂相 30 のTgの低下を防止するため40重量部以下とされる。 フェノキシ樹脂は、東都化成株式会社から、フェノトー トYP-40、フェノトートYP-50という商品名で 市販されている。また、フェノキシアソシエート社か ら、PKHC、PKHH、PKHJいう商品名で市販さ れている。高分子量エポキシ樹脂は、分子量が3万~8 万の高分子量エポキシ樹脂、さらには、分子量が8万を 超える超高分子量エポキシ樹脂(特公平7-59617 号、特公平7-59618号、特公平7-59619 号、特公平7-59620号、特公平7-64911 号、特公平7-68327号公報参照)があり、何れも 日立化成工業株式会社で製造している。極性の大きい官 能基含有反応性ゴムとして、カルボキシル基含有アクリ ルゴムは、帝国化学産業株式会社から、HTR-860 Pという商品名で市販されている。

【0020】接着剤層に使用するグリシジル(メタ)アクリレート2~6重量%を含むTgが-10℃以上でかつ重量平均分子量が80万以上であるエポキシ基含有アクリル系共重合体は、帝国化学産業株式会社から市販されている商品名HTR-860P-3を使用することが 50

できる。官能基モノマーが、カルボン酸タイプのアクリ ル酸や、水酸基タイプのヒドロキシメチル (メタ) アク リレートを用いると、架橋反応が進行しやすく、ワニス 状態でのゲル化、Bステージ状態での硬化度の上昇によ る接着力の低下等の問題があるため好ましくない。ま た、官能基モノマーとして用いるグリシジル (メタ) ア クリレートの量は、2~6重量%の共重合体比とする。 接着力を得るため、2重量%以上とし、ゴムのゲル化を 防止するために6重量%以下とされる。残部はエチル (メタ) アクリレートやブチル (メタ) アクリレートま たは両者の混合物を用いることができるが、混合比率 は、共重合体のTgを考慮して決定する。Tgが-10 ℃未満であるとBステージ状態での接着剤層のタック性 が大きくなり取扱性が悪化するので、-10℃以上とさ れる。重合方法はパール重合、溶液重合等が挙げられ、 これらにより得ることができる。エポキシ基含有アクリ ル系共重合体の重量平均分子量は、80万以上とされ、 この範囲では、シート状、フィルム状での強度や可撓性 の低下やタック性の増大が少ないからである。また、分 子量が大きくなるにつれフロー性が小さく配線の回路充 填性が低下してくるので、エポキシ基含有アクリル系共 重合体の重量平均分子量は、200万以下であることが 好ましい。上記エポキシ基含有アクリル系共重合体の配 合量は、弾性率低減や成形時のフロー性抑制のため10 0 重量部以上とされ、エポキシ基含有アクリル系共重合 体の配合量が増えると、ゴム成分の相が多くなり、エポ キシ樹脂相が少なくなるため、高温での取扱い性の低下 が起こるため、300重量部以下とされる。

【0021】電子部品用接着部材の取扱性の向上、熱伝 導性の向上、溶融粘度の調整、チクソトロピック性の付 与などを目的として、無機フィラーを配合することがで きる。無機フィラーとしては、水酸化アルミニウム、水 酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウ ム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カル シウム、酸化マグネシウム、アルミナ、窒化アルミニウ ム、ほう酸アルミウイスカ、窒化ホウ素、結晶性シリ カ、非晶性シリカなどが挙げられる。熱伝導性向上のた めには、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、結 晶性シリカ、非晶性シリカ等が好ましい。溶融粘度の調 整やチクソトロピック性の付与の目的には、水酸化アル ミニウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸 マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウ ム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、アルミナ、結 晶性シリカ、非晶性シリカ等が好ましい。上記無機フィ ラー配合量は、接着剤の樹脂固形分100体積部に対し て1~20体積部が好ましい。配合の効果の点から配合 量が1体積部以上、配合量が多くなると、接着剤の貯蔵 弾性率の上昇、接着性の低下、ボイド残存による電気特 性の低下等の問題を起こすので20体積部以下とされ

【0022】接着剤層には、異種材料間の界面結合をよくするために、カップリング剤を配合することもできる。カップリング剤としては、上記と同様のカップリング剤が使用でき、その中でシランカップリング剤が好ましい。シランカップリング剤としては、 $\gamma$  ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$  ーアミノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma$  ーウレイドプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma$  ーウレイドプロピルトリエトキシシラン等が挙げられる。カップリング剤の配合量は、添加による効果や耐熱性およびコストから、樹脂100重量部に対し0.1~10重量部を配合するのが好ましい。

【0023】さらに、接着剤層には、イオン性不純物を 吸着して、吸湿時の絶縁信頼性をよくするために、イオ ン捕捉剤を配合することができる。イオン捕捉剤の配合 量は、配合による効果や耐熱性、コストより、1~10 重量部が好ましい。イオン捕捉剤としては、銅がイオン 化して溶け出すのを防止するため銅害防止剤として知ら れる化合物、例えば、トリアジンチオール化合物、ビス・20 フェノール系還元剤を配合することもできる。ビスフェ ノール系還元剤としては、2,2'ーメチレンービスー (4-メチル-6-第3-ブチルフェノール)、4, 4'ーチオービスー(3ーメチルー6ー第3ーブチルフ エノール) 等が挙げられる。また、無機イオン吸着剤を 配合することもできる。無機イオン吸着剤としては、ジ ルコニウム系化合物、アンチモンビスマス系化合物、マ グネシウムアルミニウム系化合物等が挙げられる。トリ アジンチオール化合物を成分とする銅害防止剤は、三協 製薬株式会社から、ジスネットDBという商品名で市販 30 されている。ビスフェノール系還元剤を成分とする銅害 防止剤は、吉富製薬株式会社から、ヨシノックスBBと いう商品名で市販されている。また、無機イオン吸着剤 は、東亜合成化学工業株式会社からIXEという商品名 で各種市販されている。

【0024】本発明においてコア材の両面に備えるフィルム状の接着剤層は、接着剤の各成分を溶剤に溶解ないし分散してワニスとし、キャリアフィルム上に塗布、加熱し溶剤を除去することにより、予めキャリアフィルム上に形成する。キャリアフィルムとしては、ポリテトラ 40フルオロエチレンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリイミドフィルムなどのプラスチックフィルムが使用できる。キャリアフィルムは、使用時に剥離して接着フィルムのみを使用することもできるし、キャリアフィルムとともに使用し、後で除去することもできる。本発明で用いるキャリアフィルムの例として、ポリイミドフィルムは、東レ・デュポン株式会社からカプトンという商品名で、鐘淵化 50

学工業株式会社からアピカルという商品名で市販されている。ポリエチレンテレフタレートフィルムは、東レ・デュポン株式会社からルミラーという商品名で、帝人株式会社からピューレックスという商品名で市販されている。

【0025】ワニス化の溶剤は、比較的低沸点の、メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、2ーエトキシエタノール、トルエン、ブチルセルソルブ、メタノール、エタノール、2ーメトキシエタノールなどを用いるのが好ましい。また、塗膜性を向上するなどの目的で、高沸点溶剤を加えても良い。高沸点溶剤としては、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、メチルピロリドン、シクロヘキサノンなどが挙げられる。ワニスの製造は、無機フィラーの分散を考慮した場合には、らいかい機、3本ロール及びビーズミル等により、またこれらを組み合わせて行なうことができる。フィラーと低分子量物をあらかじめ混合した後、高分子量物を配合することにより、混合に要する時間を短縮することも可能となる。また、ワニスとした後、真空脱気によりワニス中の気泡を除去することが好ましい。

【0026】本発明の接着剤層硬化物の動的粘弾性測定装置で測定した貯蔵弾性率は、25℃で20~2,000MPa、260℃で3~50MPaという低弾性率であることが好ましい。貯蔵弾性率の測定は、接着剤層硬化物に引張り荷重をかけて、周波数10Hz、昇温速度5~10℃/分で−50℃から300℃まで測定する温度依存性測定モードで行った。貯蔵弾性率が25℃で2,000MPaを超えるものと260℃で50MPaを超えるものでは、半導体チップと配線基板であるインターポーザとの熱膨張係数の差によって発生する熱応力を緩和させる効果が小さくなり、剥離やクラックを発生する恐れがある。一方、貯蔵弾性率が25℃で20MPa未満では接着剤の取扱性や接着剤層の厚み精度が悪くなり、260℃で3MPa未満ではリフロークラックを発生しやすくなる。

【0027】本発明の半導体搭載用配線基板に用いる配線基板としては、セラミック基板や有機基板など基板材質に限定されることなく用いることができる。セラミック基板としては、アルミナ基板、窒化アルミ基板などを用いることができる。有機基板としては、ガラスマレイミドートリアジン樹脂を含浸させたBT基板、ビスマレイミドートリアジン樹脂を含浸させたBT基板、ビスマレイミドフィルムを基材として用いたポリイミドフィルムを基材として用いたポリイミドフィルムを基材として用いたポリイミにフィルム基板などを用いることができる。配線の形状としては、片面配線、両面配線、多層配線いずれの構造でもよい、片面配線、両面配線、多層配線いずれの構造でもよく、必要に応じて電気的に接続された貫通孔、非貫通表に現けてもよい。さらに、配線が半導体装置の外部ました。電子部品用接着部材を配線基板へ張り付ける方法としては、電子部品用接着部材を所定の形状に切断し、そ

12

の切断された電子部品用接着部材を配線基板の所望の位置に熱圧着する方法が一般的ではあるが、これに制限するものではない。

【0028】本発明の半導体装置の構造としては、半導 体チップの電極と配線基板とがワイヤボンディングで接 続されている構造、半導体チップの電極と配線基板とが テープオートメーテッドボンディング(TAB)のイン ナーリードボンディングで接続されている構造等がある がこれらに限定されるものではなくいずれでも効果があ る。電子部品用接着部材を用いて半導体装置を組み立て る方法を図1~図3を例に説明するが、本発明はこれに 制限されるものではない。電子部品用接着部材は、図1 に示すように無機物の織布または不織布からなるコア材 2の両面に接着剤層1を備えて構成され、図2に示す配 線3を形成した配線基板4の配線側に、所定の大きさに 切り抜いた電子部品用接着部材を例えば140℃、0. 5MPa、5秒の一定条件で熱圧着して半導体搭載用配 線基板を得、そして、電子部品用接着部材の配線基板と 反対側に半導体チップ5を例えば170℃、1MPa、 5秒の条件で熱圧着し、これを170℃、1時間加熱し て電子部品用接着部材の接着剤層を硬化させた後、図3 (a) では半導体チップのパッドと基板上の配線とをボ ンディングワイヤ6で接続し、図3(b)では半導体チ ップのパッドに基板のインナーリード6'をボンディン グして、封止材7で封止、外部接続端子8であるはんだ ボールを設けて半導体装置を得ることができる。半導体 チップと配線基板の間に発生する熱応力は、半導体チッ プと配線基板の面積差が小さい場合に著しいが、本発明 による半導体装置は低弾性率の電子部品用接着部材を用 いることによりその熱応力を緩和して信頼性を確保する ものである。これらの効果は、半導体チップの面積が、 配線基板の面積の70%以上である場合に非常に有効に 現われるものである。また、このように半導体チップと 配線基板の面積差が小さい半導体装置においては、外部 接続端子はエリア状に設けられる場合が多い。

【0029】本発明の接着部材を用いて半導体チップと配線基板を接着させた半導体装置は、耐温度サイクル性、吸湿処理後の耐リフロー性や耐PCT性等に優れていた。以下実施例により本発明をさらに具体的に説明する。

#### [0030]

【実施例】(接着剤ワニス1) エポキシ樹脂としてビスフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量190、油化シェルエポキシ株式会社製商品名エピコート828を使用) 45重量部、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(エポキシ当量195、住友化学工業株式会社製商品名ESCN195を使用) 15重量部、エポキシ樹脂の硬化剤としてフェノールノボラック樹脂(大日本インキ化学工業株式会社製商品名プライオーフェンLF2882を使用) 40重量部、エポキシ樹脂と相容性がありか 50

つ重量平均分子量が3万以上の高分子量樹脂としてフェ ノキシ樹脂(分子量5万、東都化成株式会社製商品名フ ェノトートYP-50を使用) 15重量部、エポキシ基 含有アクリル系重合体としてエポキシ基含有アクリルゴ ム (分子量100万、Tg-7℃、帝国化学産業株式会 社製商品名HTR-860P-3を使用)150重量 部、硬化促進剤として1-シアノエチル-2-フェニル イミダゾール(四国化成工業株式会社製商品名、キュア ゾール2PZ-CNを使用) 0.5 重量部、シランカッ プリング剤としてγ-グリシドキシプロピルトリメトキ シシラン (日本ユニカー株式会社製商品名NUC A-187を使用) 0. 7重量部からなる組成物に、メチル エチルケトンを加えて撹拌混合し、真空脱気した。この 接着剤ワニスを、厚さ75μmの離型処理したポリエチ レンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5 分間加熱乾燥して膜厚が 5 0 μ m の塗膜とし、接着剤フ ィルムを作製した。この接着剤フィルムを170℃で1 時間加熱硬化させてその貯蔵弾性率を動的粘弾性測定装 置(レオロジ社製、DVE-V4)を用いて測定(サン プルサイズ:長さ20mm、幅4mm、膜厚50μm、 昇温速度5℃/分、引張りモード、自動静荷重、周波数 10Hz) した結果、25℃で360MPa、260℃ で4MPaであった。

【0031】 (接着剤ワニス2) エポキシ樹脂としてビ スフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量175、 東都化成株式会社製商品名YD-8125を使用)15 重量部、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(エポキ シ当量210、東都化成株式会社製商品名YDCN-7 03を使用) 45重量部、エポキシ樹脂の硬化剤として フェノールノボラック樹脂(大日本インキ化学工業株式 会社製商品名プライオーフェンLF2882を使用) 4 0 重量部、エポキシ基含有アクリル系重合体としてエポ キシ基含有アクリルゴム (分子量100万、Tg-7 ℃、帝国化学産業株式会社製商品名HTR-860P-3を使用) 150重量部、硬化促進剤として1-シアノ エチルー2-フェニルイミダゾール (四国化成工業株式 会社製商品名キュアゾール2PZ-CNを使用) 0.5 重量部、シランカップリング剤としてッーグリシドキシ プロピルトリメトキシシラン(日本ユニカー株式会社製 商品名NUC A-187を使用) 0.7重量部からな る組成物に、メチルエチルケトンを加えて撹拌混合し、 真空脱気した。この接着剤ワニスを、厚さ75μmの離 型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗 布し、140℃で5分間加熱乾燥して膜厚が80μmの **塗膜とし、接着剤フィルムを作製した。この接着剤フィ** ルムを170℃で1時間加熱硬化させてその貯蔵弾性率 を動的粘弾性測定装置(レオロジ社製、DVE-V4) を用いて測定(サンプルサイズ:長さ20mm、幅4m m、膜厚80μm、昇温速度5℃/分、引張りモード、 自動静荷重、周波数10Hz) した結果、25℃で35

OMPa、260℃で4MPaであった。

【0032】 (接着剤ワニス3) エポキシ樹脂としてビ スフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量190、 油化シェルエポキシ株式会社製商品名エピコート828 を使用) 45重量部、クレゾールノボラック型エポキシ 樹脂(エポキシ当量195、住友化学工業株式会社製商 品名ESCN195を使用) 15重量部、エポキシ樹脂 の硬化剤としてフェノールノボラック樹脂(大日本イン キ化学工業株式会社製商品名プライオーフェンLF28 82を使用) 40重量部、エポキシ樹脂と相溶性があり かつ重量平均分子量が3万以上の高分子量樹脂としてフ エノキシ樹脂(分子量5万、東都化成株式会社製商品名 フェノトートYP-50を使用) 15重量部、エポキシ 基含有アクリル系重合体としてエポキシ基含有アクリル ゴム(分子量100万、Tg-7℃、帝国化学産業株式 会社製商品名HTR-860P-3を使用) 50 重量 部、硬化促進剤として1-シアノエチル-2-フェニル イミダゾール(四国化成工業株式会社製商品名キュアゾ ール2PZ-CNを使用) 0.5重量部、シランカップ リング剤としてγーグリシドキシプロピルトリメトキシ 20 シラン (日本ユニカー株式会社製商品名NUC A-1 87を使用) 0. 7重量部からなる組成物に、メチルエ チルケトンを加えて撹拌混合し、真空脱気した。この接 着剤ワニスを、厚さ75μmの離型処理したポリエチレ ンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分 間加熱乾燥して膜厚が80μmの塗膜とし、接着剤フィ ルムを作製した。この接着剤フィルムを170℃で1時 間加熱硬化させてその貯蔵弾性率を動的粘弾性測定装置 (レオロジ社製、DVE-V4) を用いて測定 (サンプ ルサイズ:長さ20mm、幅4mm、膜厚80μm、昇 30 温速度5℃/分、引張りモード、自動静荷重、周波数1 OHz) した結果、25℃で3000MPa、260℃ で5MPaであった。

【0033】(接着剤ワニス4)エポキシ樹脂としてビ スフェノールA型エポキシ樹脂 (エポキシ当量175、 東都化成株式会社製商品名 Y D - 8 1 2 5 を使用) 1 5 重量部、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 (エポキ シ当量210、東都化成株式会社製商品名YDCN-7 03を使用) 45重量部、エポキシ樹脂の硬化剤として フェノールノボラック樹脂(大日本インキ化学工業株式 40 会社製商品名プライオーフェンLF2882を使用) 4 0 重量部、エポキシ基含有アクリル系重合体としてエポ キシ基含有アクリルゴム (分子量100万、Tg-7 ℃、帝国化学産業株式会社製商品名HTR-860P-3を使用) 400重量部、硬化促進剤として1-シアノ エチルー2-フェニルイミダゾール (四国化成工業株式 会社製商品名キュアゾール2PZ-CNを使用) 0.5 重量部、シランカップリング剤としてγーグリシドキシ プロピルトリメトキシシラン (日本ユニカー株式会社製 商品名NUC A-187を使用) 0.7重量部からな 50

る組成物に、メチルエチルケトンを加えて撹拌混合し、 真空脱気した。この接着剤ワニスを、厚さ75μmの離 型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗

布し、140℃で5分間加熱乾燥して膜厚が $80\mu$ mの 塗膜とし、接着剤フィルムを作製した。この接着剤フィ ルムを170℃で1時間加熱硬化させてその貯蔵弾性率 を動的粘弾性測定装置(レオロジ社製、DVE-V4) を用いて測定(サンプルサイズ:長さ20mm、幅4m

14

m、膜厚80μm、昇温速度5℃/分、引張りモード、 自動静荷重、周波数10H z)した結果、25℃で20 0MPa、260℃で1MPaであった。

【0034】(実施例1)接着剤ワニス1を、厚さ75 μmの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、膜厚が25μmのBステージ状態の塗膜を形成し、キャリアフィルムを備えた接着フィルムを作製した。この接着フィルムを、厚さ100μmのシランカップリング剤処理済みEガラスを用いたガラス織布(日東紡績株式会社製の2116タイプを使用)の両面に温度110℃、圧力0.3MPa、速度0.2m/分の条件でホットロールラミネーターを用いて貼り付け、ガラス織布の両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0035】(実施例2)接着剤ワニス2を、厚さ75 μmの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、膜厚が50μmのBステージ状態の塗膜を形成し、キャリアフィルムを備えた接着フィルムを作製した。この接着フィルムを、厚さ60μmのシランカップリング剤処理済みEガラスを用いたガラス織布(日東紡績株式会社製の1080タイプを使用)の両面に温度110℃、圧力0.3MPa、速度0.2m/分の条件でホットロールラミネーターを用いて貼り付け、ガラス織布の両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0036】(実施例3)接着剤ワニス2を、厚さ75  $\mu$  mの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、膜厚が $30\mu$  mのBステージ状態の塗膜を形成し、キャリアフィルムを備えた接着フィルムを作製した。この接着フィルムを、厚さ $60\mu$  mのシランカップリング剤処理済みEガラスを用いたガラス織布(日東紡績株式会社製の106タイプを使用)の両面に温度110℃、圧力0.3 MPa、速度0.2 m/分の条件でホットロールラミネーターを用いて貼り付け、ガラス織布の両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0037】(実施例4)接着剤ワニス2を、厚さ75μmの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、膜厚が50μmのBステージ状態の塗膜を形成し、キャリアフィルムを備えた接着フィルムを作製した。この接着フィルムを、シランカップリング剤処理を施した坪量50g

/m²のガラス不織布 (日本バイリーン株式会社製商品名EPM-4050Nを使用)の両面に温度110℃、圧力0.3MPa、速度0.2m/分の条件でホットロールラミネーターを用いて貼り付け、ガラス不織布の両面に接着剤層を備えた接着部材を作製した。

【0038】 (比較例1) 接着剤ワニス2を、厚さ75 μmの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、膜厚が60μmのBステージ状態の塗膜を形成し、キャリアフィルムを備えた接着フィルムを作製した。この接着フィルムを、厚さ30μmのシランカップリング剤処理済みアルミナ板の両面に温度110℃、圧力0.3MPa、速度0.2m/分の条件でホットロールラミネーターを用いて貼り付け、アルミナ板の両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0039】(比較例2)接着剤ワニス2を、厚さ75  $\mu$  mの離型処理したポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、膜厚が75  $\mu$  mのBステージ状態の塗膜を形成し、キャリアフィルムを備えた接着フィルムを作製した。この接着フィルムを、厚さ25  $\mu$  mのポリイミドフィルム(宇部興産株式会社製商品名ユーピレックスSGAを使用)の両面に温度110℃、圧力0.3MPa、速度0.2 m/分の条件でホットロールラミネーターを用いて貼り付け、ポリイミドフィルムの両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。この接着部材は、他の実施例、比較例の接着部材と比較し、室温で柔軟なため取り扱い性が悪かった。

【0040】(参考例1)接着剤ワニス1を接着剤ワニス3とした以外は実施例1と同様にして、ガラス織布の 30 両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0041】(参考例2)接着剤ワニス1を接着剤ワニス4とした以外は実施例1と同様にして、ガラス織布の両面に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0042】 (参考例3) ガラス織布を厚さ100μm のシランカップリング剤未処理のEガラスを用いたガラ ス織布(日東紡績株式会社製の2116タイプを使用) とした以外は実施例1と同様にして、ガラス織布の両面 に接着剤層を備えた電子部品用接着部材を作製した。

【0043】得られた電子部品用接着部材を用いて図3 (b) に示す半導体チップ5と厚み25μmのポリイミ ドフィルムを基材に用いた配線基板4を任意の大きさに 金型で打ち抜き、電子部品用接着部材を介して貼り合せ た半導体装置サンプル (片面にはんだボール8を形成) を作製し、温度サイクルテスト、吸湿処理後の耐リフロ 一性、耐PCT性を調べた。温度サイクル試験は、サン プルを-55℃雰囲気に30分間放置し、その後125 **℃の雰囲気に30分間放置する工程を1サイクルとし** て、1000サイクル後に目視と超音波顕微鏡により観 察し、剥離やクラック等の破壊が発生していないものを 〇とし、発生していたものを×とした。吸湿処理後の耐 リフロー性は、温度30℃、相対湿度60%で192時 間吸湿させたサンプルをサンプル表面の最高温度が24 0℃でこの温度を20秒間保持するように温度設定した IRリフロー炉に通し、室温で放置することにより冷却 する処理を2回繰り返したサンプル中の剥離やクラック を超音波顕微鏡により観察して評価した。剥離やクラッ クの発生していないものを○とし、発生していたものを ×とした。耐PCT性は、温度121℃、相対湿度10 0%、2気圧の雰囲気で96時間処理を行い、電子部品 用接着部材の剥離を超音波顕微鏡で観察した。電子部品 用接着部材の剥離の認められなかったものを〇とし、剥 離のあったものを×とした。また、加工性については、 電子部品用接着部材を100ショット打ち抜いた後に金 型の欠けが認められたものを×とし、さらに、打ち抜い た電子部品用接着部材の端部が白化しているものも×と した。これらの不具合が発生しないものを○とした。取 扱性については、打ち抜いた電子部品用接着部材の端部 をピンセットで持った場合に折れ曲がって接着剤同士が ブロッキングするものを×とし、それ以外を○とした。 その結果を表1に示した。

[0044]

【表1】

評価項目	実施例			比較例			参考例		
	1	2	3	4	1_	2_	1_	2	3
耐温度サイクル性	0	0	0	0	0	0	×	0	×
吸湿後の耐リフロー性	0	0	0	0	0	0	×	×	×
耐PCT性	0	0	0	0	0	0	0	_ O	×
加工性	0	0	0	0	×	0	0	0	×
取扱性	0	0	0	0	0	×	0	0	0

【0045】実施例1~3は、何れもシランカップリング剤処理を施したガラス織布をコア材として、その両面に接着剤層の硬化物が25℃での貯蔵弾性率が20~2,000MPa及び260℃での貯蔵弾性率が3~50MPaを示す接着剤を用いている。また、実施例4

は、シランカップリング剤処理を施したガラス不織布をコア材として、その両面に接着剤層の硬化物が上記の25℃及び260℃での貯蔵弾性率を示す接着剤を用いている。これらの電子部品用接着部材を用いた半導体装置は、耐温度サイクル性、吸湿処理後の耐リフロー性、耐

PCT性が良好であった。また、加工性、取扱性も良好 であった。比較例1は、耐温度サイクル性、吸湿処理後 の耐リフロー性、耐PCT性が良好であったが、電子部 品用接着部材のコア材として無機物の織布や不織布でな くアルミナ板を用いたため、加工性が劣っていた。比較 例2は、吸湿処理後の耐リフロー性、耐PCT性が良好 であったが、電子部品用接着部材のコア材として無機物 の織布や不織布でなくポリイミドフィルムを用いたため 取扱性に劣っていた。参考例1は、接着剤に含まれるエ ポキシ基含有アクリル系共重合体の量が少なすぎるため 貯蔵弾性率が高く、耐温度サイクル性、吸湿処理後の耐 リフロー性に劣る。参考例2は、エポキシ基含有アクリ ル系共重合体の量が多すぎるため貯蔵弾性率が低く、吸 湿処理後の耐リフロー性に劣る。参考例3は、電子部品 用接着部材のコア材としてカップリング剤処理されてい ないガラス織布を用いたため、各試験後の観察でガラス 織布と接着剤層との間に剥離が発生していて信頼性に劣 っていた。また、打ち抜き加工した電子部品用接着部材 の端部が白化しており、加工性も悪かった。

#### [0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電子部品 用接着部材を用いて半導体チップと配線基板を接着した 半導体装置は、半導体チップと配線基板との熱膨張率差 から加熱冷却時に発生する熱応力を電子部品用接着部材 が緩和させることができるため、耐温度サイクル性および吸湿処理後の耐リフロー性に優れている。また、耐湿性に優れた接着剤を用いているため、耐PCT性にも優れている。さらに、本発明の電子部品用接着部材は加工性や取扱性にも優れており、優れた信頼性を発現する半導体装置を効率的に作製するのに必要な接着材料を提供することができる。

18

#### 【図面の簡単な説明】

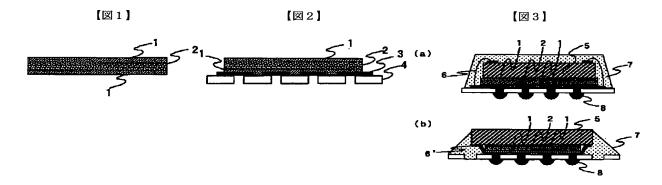
【図1】 本発明の電子部品用接着部材の断面図。

【図2】 本発明の半導体チップ搭載面に電子部品用接着部材を備えた半導体搭載用配線基板の断面図。

【図3】 (a) および (b) は本発明による電子部品 用接着部材を用いた半導体装置の断面図。

#### 【符号の説明】

- 1 . 接着剤層
- 2. コア材
- 3. 配線
- 4 . 配線基板
- 5 . 半導体チップ
- 20 6 . ボンディングワイヤ
  - 6'. インナーリード
  - 7. 封止材
  - 8 . 外部接続端子



#### フロントページの続き

(72) 発明者 稲田 禎一

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成 工業株式会社下館研究所内

(72) 発明者 田中 裕子

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成 工業株式会社下館研究所内

(72) 発明者 神代 恭

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成 工業株式会社下館研究所内 (72)発明者 山本 和徳

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館研究所内

Fターム(参考) 4J040 EB031 EB032 EC001 EC232

EC361 EC362 EE062 JA09
KA16 KA17 LA01 LA02 LA06
MB02 NA19 NA20 PA03

5F047 AA07 BA21